

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 2 部門第 3 区分
 【発行日】平成21年9月10日 (2009.9.10)

【公表番号】特表2009-511283(P2009-511283A)
 【公表日】平成21年3月19日 (2009.3.19)
 【年通号数】公開・登録公報2009-011
 【出願番号】特願2008-534863(P2008-534863)
 【国際特許分類】

B 2 3 P 15/28 (2006.01)
 B 2 3 B 27/14 (2006.01)
 B 2 3 C 5/16 (2006.01)
 B 2 3 B 51/00 (2006.01)
 C 2 3 C 16/36 (2006.01)

【F I】

B 2 3 P 15/28 A
 B 2 3 B 27/14 A
 B 2 3 C 5/16
 B 2 3 B 51/00 J
 C 2 3 C 16/36

【手続補正書】
 【提出日】平成21年7月24日 (2009.7.24)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

周期律表の第 I V a 族～第 V I a 族の金属の炭窒化物からなる少なくとも 1 つの層の C V D 堆積による、被覆された基材成形体の製造法において、ガス雰囲気中に有機炭素キャリアとしての少なくとも 1 種の単環式炭化水素及び窒素キャリアとしての少なくとも 1 種のニトリル又はアミン又は複素環式炭化水素又はこれらの混合物が存在し、その際、窒素キャリア対単環式炭化水素の比が 2 : 1 ～ 1 : 16 であることを特徴とする、被覆された基材成形体の製造法。

【手続補正 2】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0014
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【0014】

第一に述べた課題は、請求項 1 記載の方法により解決される。本発明によれば、ガス雰囲気中で C V D 堆積の間に有機窒素キャリア、有利にニトリルに加えて、更に有機炭素キャリア、有利に単環式炭化水素が使用される。